



【筑波 GaNの結晶成長技術開発研究者】ご経験者を募集しています。

国内最大手の石油化学メーカー

募集職種

人材紹介会社

株式会社グローバル・リサーチ

採用企業名

国内最大手の石油化学メーカー

求人ID

1603604

部署名

茨城事業所

業種

化学・素材

会社の種類

大手企業 (300名を超える従業員数)

雇用形態

正社員

勤務地

茨城県, 牛久市

給与

750万円 ~ 1400万円

更新日

2026年09月10日 05:00

応募必要条件

職務経験

6年以上

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

基礎会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

次世代パワー半導体である窒化ガリウム（GaN）の気相法による結晶成長技術開発をご担当いただきます。
中長期的な視点に立ち、特に次世代製品（大口径基板・低欠陥密度基板・低抵抗品基板 等）の新製品開発に重きを置いた、挑戦的かつ自由度の高い開発業務をお任せします。

< 担当業務項目 >

GaNの結晶成長技術の開発業務を中心に、ご経験やご希望などを踏まえて以下に例示する担当業務をご提案いたします。

本ポジションは中長期の技術開発・新製品創出を担う"攻めの研究開発"を行うポジションです。

1) 新製品の結晶成長技術開発：大口径・低欠陥密度・低抵抗品など、次世代基板の結晶成長技術を創り上げる開発業務を行います。

2) 既存製品の歩留り改善や、品質安定化：結晶成長起因の歩留り低下や品質不良に関する不良に対し、原因解析からプロセス改善まで一気通貫で歩留まり向上を図ります。

スキル・資格

【必須条件】

- ・化合物半導体の結晶成長技術開発、もしくは結晶成長・薄膜成長に関連する技術開発の経験

【歓迎要件】

- ・物理、化学、化学工学、材料科学、機械工学、電気・電子工学（特に化合物半導体の結晶成長を専攻していた方）
- ・GaN（窒化ガリウム）の結晶成長技術開発、ウエハ加工等の経験（即戦力として特に歓迎）
- ・語学力：英語

会社説明

国内最大手の石油化学メーカー